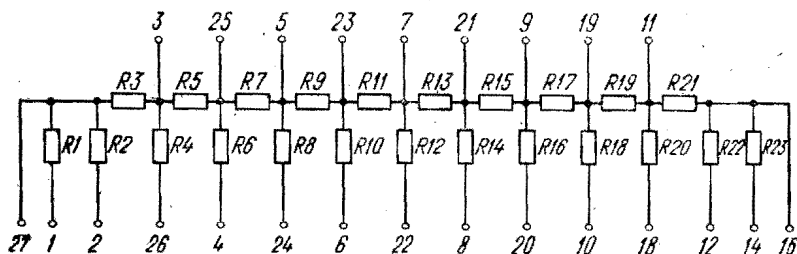


301НР5А—
301НР5М

ДЕКОДИРУЮЩАЯ РЕЗИСТИВНАЯ МАТРИЦА
ТИПА R—2R

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

(при температуре 25°C)

Входное напряжение на выводах 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18, 20, 22, 24, 26 относительно вывода 1, В, не более . . .	12,6
Сопротивление изоляции (испытательное напряжение 100 В прикладывается между экраном и закороченными выводами), МОм	100
Сопротивление резисторов, кОм:	
2R	от 18,425 до 21,575
R	от 9,212 до 10,788
Относительная погрешность коэффициентов деления, %	±0,01
Время установления переходных процессов, мкс, не более	1

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ
И РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Максимальная рассеиваемая мощность, мВт	150
---	-----

ДЕКОДИРУЮЩАЯ РЕЗИСТИВНАЯ МАТРИЦА
ТИПА R-2R

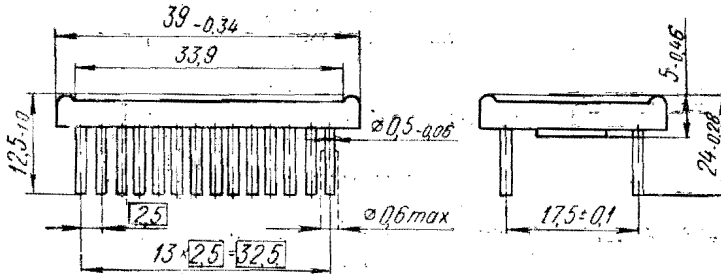
301НР5А—
301НР5М

Пози- цион- ное обо- зна- чение	Расчетный номинал, Ом, для типов микросхем											301НР5М				
	301НР5А	301НР5Б	301НР5В	301НР5Г	301НР5Д	301НР5Е	301НР5Ж	301НР5И	301НР5К	301НР5Л	301НР5Л					
R1	2R	2R	2R	2R	2R	2R	2R	2R	2R	2R	2R	2R	2R	2R	2R	2R
R2	2R	2R-10	2R-20	2R-30	2R-40	2R-50	2R-60	2R-70	2R-80	2R-90	2R-100	2R	2R	2R-90	2R-100	R
R3	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
R4	2R	2R-10	2R-20	2R-30	2R-40	2R-50	2R-60	2R-70	2R-80	2R-90	2R-100	2R	2R	2R-90	2R-100	R
R5	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
R6	2R	2R-10	2R-20	2R-30	2R-40	2R-50	2R-60	2R-70	2R-80	2R-90	2R-100	2R	2R	2R-90	2R-100	R
R7	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
R8	2R	2R-10	2R-20	2R-30	2R-40	2R-50	2R-60	2R-70	2R-80	2R-90	2R-100	2R	2R	2R-90	2R-100	R
R9	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
R10	2R	2R-10	2R-20	2R-30	2R-40	2R-50	2R-60	2R-70	2R-80	2R-90	2R-100	2R	2R	2R-90	2R-100	R
R11	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
R12	2R	2R-10	2R-20	2R-30	2R-40	2R-50	2R-60	2R-70	2R-80	2R-90	2R-100	2R	2R	2R-90	2R-100	R
R13	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
R14	2R	2R-10	2R-20	2R-30	2R-40	2R-50	2R-60	2R-70	2R-80	2R-90	2R-100	2R	2R	2R-90	2R-100	R
R15	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
R16	2R	2R-10	2R-20	2R-30	2R-40	2R-50	2R-60	2R-70	2R-80	2R-90	2R-100	2R	2R	2R-90	2R-100	R
R17	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
R18	2R	2R-10	2R-20	2R-30	2R-40	2R-50	2R-60	2R-70	2R-80	2R-90	2R-100	2R	2R	2R-90	2R-100	R
R19	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
R20	2R	2R-10	2R-20	2R-30	2R-40	2R-50	2R-60	2R-70	2R-80	2R-90	2R-100	2R	2R	2R-90	2R-100	R
R21	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
R22	2R	2R-10	2R-20	2R-30	2R-40	2R-50	2R-60	2R-70	2R-80	2R-90	2R-100	2R	2R	2R-90	2R-100	R
R23	2R	2R-10	2R-20	2R-30	2R-40	2R-50	2R-60	2R-70	2R-80	2R-90	2R-100	2R	2R	2R-90	2R-100	R

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ 301

Общие данные

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



Масса не более 10 г.

ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ

Синусоидальная вибрация:

диапазон частот, Гц

для микросхем 301НР1—301НР6	от 1 до 3000
» » 301НР7—301НР12	от 1 до 5000

амплитуда ускорения, м·с⁻² (g)

для микросхем 301НР1—301НР6	150 (15)
» » 301НР7—301НР12	400 (40)

Механический удар одиночного действия:

пиковое ударное ускорение, м·с⁻² (g)

для микросхем 301НР1—301НР6	5000 (500)
» » 301НР7—301НР12	15 000 (1500)

длительность действия ударного ускорения, мс

от 0,1 до 2,0

Механический удар многократного действия:

пиковое ударное ускорение, м·с⁻² (g)

для микросхем 301НР1—301НР6	750 (75)
» » 301НР7—301НР12	1500 (150)

длительность действия ударного ускорения, мс

от 1 до 5

Линейное ускорение, м·с⁻² (g)

1500 (150)

Повышенная температура среды, °С:

для микросхем 301НР1—301НР6	85
» » 301НР7—301НР12	100

Пониженная температура среды, °С

минус 60

Изменения температуры среды, °С:

для микросхем 301НР1—301НР6	от минус 60 до +85
» » 301НР7—301НР12	от минус 60 до +100

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ 301

Общие данные

Атмосферное пониженное давление, мм рт. ст. (Па):	
для микросхем 301НР1—301НР6	5 (665)
» » 301НР7—301НР12	10 ⁻⁸
Атмосферное повышенное давление, атм	3
Иней, роса.	
Соляной туман.	
Среда, зараженная плесневыми грибами.	

НАДЕЖНОСТЬ

Минимальная наработка ^О , ч	25 000
Срок сохраняемости ^О , лет	25

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Микросхемы следует применять и эксплуатировать в соответствии с ОСТ В 11 073.041—82 и требованиями, изложенными ниже.

Допускается кратковременная двухкратная перегрузка по напряжению на входах с сохранением характеристик во время и после снятия перегрузки. Длительность воздействия перегрузки для микросхем 301НР1—301НР6 — 2 мин, для микросхем 301НР7—301НР12 — 5 мин, количество перегрузок — не более 5 в течение 1 ч, интервал между перегрузками — не менее 8—10 мин.

Выводы микросхем формовке не подлежат. В технически обоснованных случаях допускается удалять нерабочие выводы микросхем и излишки рабочих выводов после пайки любым способом, исключаям нарушение запрессовки вывода в основании корпуса и не приводящим к ухудшению электрических параметров микросхем.

^О В условиях и режимах, допускаемых ОТУ или ТУ.